PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-008863

(43) Date of publication of application: 11.01.2002

(51)Int.Cl.

H05B 33/14 C07C211/61 C09K 11/06

(21)Application number: 2000-

(71)Applicant: TORAY IND INC

184269

(22)Date of filing:

20.06.2000 (72)Inventor: TOMINAGA TAKESHI

MURASE SEIICHIRO

KOHAMA TORU

(54) LIGHT-EMITTING ELEMENT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a red light-emitting element of high electric energy utilization efficiency and an excellent color purity.

SOLUTION: This element has a luminous material between an anode and a cathode and emits light of a peak wavelength of 580 nm to 750 nm by electric energy. The element contains at least a fluorescent compound of a fluorescent peak wavelength of 540 nm to 750 nm and a chemical compound expressed as the following general formula (1).

$$R_3$$
 R_4
 R_1
 R_1
 R_1

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(II)特許出願公開番号 特開2002-8863

(P2002-8863A)

(43)公開日 平成14年1月11日(2002.1.11)

(51) Int.Cl. ⁷	歲 別配号	FΙ			テーマコー)*(参考)	
H05B 33/14		H05B 3	3/14		В 3 Р	007	
C 0 7 C 211/61		C 0 7 C 211/61			4H006		
C 0 9 K 11/06	6 3 0	C09K 1	1/06	630			
	660			6 6 0 6 9 0			
	690						
		審查請求	未請求	請求項の数7	OL	(全 17 頁)	
(21)出願番号	特顧2000-184269(P2000-184269)	(71) 出題人					
			東レ株式	式会社			
(22) 出版日	平成12年6月20日(2000.6.20)	東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号					
		(72)発明者	72) 発明者 富永 剛				
			滋賀県	大津市園山1丁	目1番1	号 東レ株	
			式会社社	放資事業場内			
		(72)発明者	村瀬	青一郎			
		i	滋賀県	大津市園山1丁	目1番1	号 東レ株	
		i	式会社社	放賽事業場内			
		(72)発明者	小濱	学			
		i i	滋賀県	大津市運山1丁	月1番1	号 東レ株	

(54) 【発明の名称】 発光素子

(57)【要約】 (修正有)

【課題】電気エネルギーの利用効率が高く、色純度に優れた赤色発光素子を提供する。

【解決手段】陽極と陰極の間に発光物質が存在し、電気エネルギーによりピーク波長が580 nm以上720 nm以下に発光する素子であって、該素子は少なくとも蛍光ピーク波長が540 nm以上720 nm以下の蛍光化合物と下記一般式(1)で表される化合物を含むことを特徴とする発光素子。

$$A_1$$
 A_2
 A_1
 A_3
 A_4
 A_1
 A_2
 A_2
 A_1
 A_2
 A_2
 A_1
 A_2
 A_2
 A_2
 A_1
 A_2
 A_2
 A_2
 A_3
 A_1
 A_2
 A_2
 A_3
 A_3
 A_4
 A_1
 A_2
 A_3
 A_3
 A_4
 A_3
 A_4
 A_4

【特許請求の範囲】

【請求項1】陽極と陰極の間に発光物質が存在し、電気エネルギーによりビーク波長が580mm以上720mm以下に発光する素子であって、該素子は少なくとも蛍光ピーク波長が540mm以上720mm以下の蛍光化合物と下記一般式(1)で表される化合物を含むことを特徴とする発光素子。

【化1】

$$R_3$$
 R_4
 X_1
 R_1
 R_1
 R_1

(ここで、 人) および A2 はそれぞれ同じでも異なってい てもよく、電子吸引基、芳香複素環の中から選ばれる。 XⅠは酸素、硫黄、置換もしくは無置換の窒素より選ば れる。R:~R4はそれぞれ同じでも異なっていてもよ く、水素、アルキル、アルコキシ、ハロゲン、アリー ル、アラルキル、アルケニル、アリールエーテル、複素 20 環、シアノ、アルデヒド、カルボニル、エステル、カル バモイル、アミノ、隣接置換基との間に形成される芳香 族、脂肪族、あるいは複素環の縮合環の中から選ばれ、 かつ前記R:~R4のうち少なくとも一つは下記一般式 (2) で示される場であり、Rs、Rs、およびRrはそ れぞれ同じでも異なっていてもよく、水素、アルキル、 アルコキシ、ハロゲン、アリール、アラルキル、アルケ ニル、アリールエーテル、複素環、シアノ、アルデヒ ド、カルボニル、エステル、カルバモイル、アミノ、隣 接置換基との間に形成される芳香族、脂肪族、あるいは 30 複素質の縮合環の中から選ばれから選ばれる。)

【化2】

【請求項2】前記一般式(2)のRa~Rrのうち少なく とも一つが下記一般式(3)であることを特徴とする請 求項1記載の発光素子。

【化3】

$$---Ar-N(R_0$$
 (3)

(ここで、Arはベンゼン環が2個以上からなる置換または無置換の芳香族炭化水素であり、RsおよびRsはそれぞれ同じでも異なっていてもよく、水素、アルキル、アリール、隣接置換基との間に形成される環構造の中から選ばれる。)

【請求項3】前記一般式(2)のRs~Rrのうち少なくとも一つが置換または無置換の複素環であることを特徴 50

とする請求項1記載の発光素子。

【請求項4】該素子が少なくとも蛍光ピーク波長が540 nm以上720 nm以下の蛍光化合物と下記---般式(4)で表される化合物を含むことを特徴とする請求項1記載の発光素子。

【化4】

(ここで、A3およびA1はそれぞれ同じでも異なってい てもよく、電子吸引基、芳香複素環の中から選ばれる。 Xzは酸素、硫黄、置換もしくは無置換の窒素より選ば れる。R₁₀~R₁₂ はそれぞれ同じでも異なっていてもよ く、水素、アルキル、アルコキシ、ハロゲン、アリー ル、アラルキル、アルケニル、アリールエーテル、複素 環、シアノ、アルデヒド、カルボニル、エステル、カル バモイル、アミノ、隣接置換基との間に形成される芳香 族、脂肪族、あるいは複素環の縮合環の中から選ばれ る。Yは縮合構造を表し、置換または無置換の芳香族炭 化水素、芳香複素環の中から選ばれる。2は置換または 無置換の芳香族炭化水素、芳香複素環より選ばれる。) 【請求項5】前記蛍光化合物において、蛍光化合物の基 本骨格に、ビニル基、芳香環、あるいは複素環の少なく とも一つが置換基として導入されているか、あるいは縮 合されている、蛍光化合物の基本骨格に含まれる環構造 が複素環に置換されている、うちの少なくとも一つを含 むことを特徴とする請求項1~4のいずれか記載の記載 の発光素子。

【請求項6】前記一般式(1)および一般式(4)がドーパント材料であることを特徴とする請求項1または4記載の発光素子。

【請求項7】マトリクスおよび/またはセグメント方式 によって表示するディスプレイであることを特徴とする 請求項1記載の発光素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電気エネルギーを 光に変換できる素子であって、表示素子、フラットパネ ルディスプレイ、バックライト、照明、インテリア、標 識、看板、電子写真機、光信号発生器などの分野に利用 可能な発光素子に関する。

[0002]

【従来の技術】陰極から注入された電子と陽極から注入 された正孔が両極に挟まれた有機蛍光体内で再結合する 際に発光するという有機積層薄膜発光素子の研究が近年 活発に行われている。この素子は、薄型、低駆動電圧下 での高輝度発光、蛍光材料を選ぶことによる多色発光が 特徴であり注目を集めている。

【()()()3】この研究は、コダック社のC. W. Tan 異らが有機積層薄膜素子が高輝度に発光することを示し で以来(Appl. Phys. Lett. 51(12) 21. p. 913, 1987)、多くの研究機関が検討 を行っている。コダック社の研究グループが提示した有 機積層薄膜発光素子の代表的な構成は、ITOガラス基 板上に正孔輸送性のジアミン化合物、発光層である8-ヒドロキシキノリンアルミニウム、そして陰極としてM g:Agを順次設けたものであり、10V程度の駆動電 10 子である。 圧で1000cd/m²の緑色発光が可能であった。現 在の有機稍層薄膜発光素子は、上記の素子構成要素の他 に電子輸送層を設けているものなど構成を変えているも のもあるが、基本的にはコダック社の構成を踏襲してい る。

【()()()4】多色発光の中でも赤色発光は、有用なる発 光色として研究が進められている。従来、ビス(ジイソ プロピルフェニル) ペリレンなどのペリレン系、ペリノ ン系、ボルフィリン系、Eu鉛体(Chem.Let 1. 1267 (1991)) などが赤色発光材料とし 20 て知られている。

【()()()5】また、赤色発光を得る手法として、ホスト 材料の中に微量の赤色蛍光材料をドーパントとして混入 させる方法も検討されている。ホスト材料としては、ト リス(8ーキノリノラト)アルミニウム鉛体、ビス(1 ()ーベンゾキノリノラト) ベリリウム錯体、ジアリール ブタジエン誘導体、スチルベン誘導体、ベンズオキサゾ ール誘導体、ベンゾチアゾール誘導体などがあげられ、 その中にドーパントとして4一(ジシアノメチレン)ー 2-メチルー6- (p-ジメチルアミノスチリル) - 4 30 Hーピラン、金属フタロシアニン(MgPc、AlPc C1など)化合物、スクアリリウム化合物を存在させる ことによって赤色発光を取り出していた。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかし、従来の赤色発 光材料(ホスト材料およびドーパント材料)は、発光ピ ーク波段が580 nmを越えてもピーク幅が広いため、 色純度が悪く綺麗な赤色発光が得られなかった。また、 E u 錯体などの希土類錯体は発光ビーク幅が狭く、綺麗 な赤色発光が得られるが、最高輝度が数~数十cd/m 40 ²と低いため、明瞭な表示ができないことが問題であっ た。また、ビラン誘導体をドーパント材料に用いた例が あるが (特別平10-308281および特別平11-292875号公報)、これらはいずれもホスト材料に 蛍光ビーク波長が540 nmより短波長であるトリス (8-キノリノラト) アルミニウム錯体を用いており、 高効率発光が得られても発光色は赤槓色となるか、ある いはドーピング濃度を濃くして色純度の良い赤色発光を 得ようとすると効率が著しく低下する問題があった。

【()()()7】本発明は、かかる問題を解決し、高効率か 50

つ高色純度の赤色発光素子を提供することを目的とする ものである。

[0008]

【課題を解決するための手段】すなわち本発明は、陽極 と陰極の間に発光物質が存在し、電気エネルギーにより ピーク波長が580 nm以上720 nm以下に発光する 素子であって、該素子は少なくとも蛍光ピーク波長が5 40 nm以上720 nm以下の蛍光化合物と下記一般式 (1) で表される化合物を含むことを特徴とする発光素

[0009]

【化5】

【0010】(ここで、AiおよびAzはそれぞれ同じで も異なっていてもよく、電子吸引基、芳香複素環の中か ら選ばれる。X1は酸素、硫黄、置換もしくは無置換の 窒素より選ばれる。R1~R4はそれぞれ同じでも異なっ ていてもよく、水素、アルキル、アルコキシ、ハロゲ ン、アリール、アラルキル、アルケニル、アリールエー テル、複素環、シアノ、アルデヒド、カルボニル、エス テル、カルバモイル、アミノ、隣接置換基との間に形成 される芳香族、脂肪族、あるいは複素環の縮合環の中か ら選ばれ、かつ前記Ri~Riのうち少なくとも一つは下 記一般式(2)で示される基であり、Rs、Rs、および Riはそれぞれ同じでも異なっていてもよく、水素、ア ルキル、アルコキシ、ハロゲン、アリール、アラルキ ル、アルケニル、アリールエーテル、複素環、シアノ、 アルデヒド、カルボニル、エステル、カルバモイル、ア ミノ、隣接置換基との間に形成される芳香族、脂肪族、 あるいは複素環の縮合環の中から選ばれから選ばれ る。)

[0011]

【化6】

$$\begin{array}{c}
 & R_6 \\
R_7 & R_5
\end{array}$$

[0012]

【発明の実施の形態】本発明において陽極は、光を取り 出すために透明であれば酸化錫、酸化インジウム、酸化 **錫インジウム(ITO)などの導電性金属酸化物、ある** いは金、銀、クロムなどの金属、ヨウ化銅、硫化銅など の無機導電性物質、ポリチオフェン、ポリピロール、ポ リアニリンなどの導電性ポリマなど特に限定されるもの でないが、ITOガラスやネサガラスを用いることが特 に望ましい。透明電極の抵抗は素子の発光に十分な電流 が供給できればよいので限定されないが、素子の消費電 力の観点からは低低抗であることが望ましい。例えば3 0.0Ω/ 『以下のITO基板であれば素子電極として機 能するが、現在では100/三程度の基板の供給も可能 になっていることから、低抵抗品を使用することが特に 望ましい。 「T()の厚みは抵抗値に合わせて任意に選ぶ 事ができるが、通常100~300mmの間で用いられ ることが多い。また、ガラス基板はソーダライムガラ ス、無アルカリガラスなどが川いられ、また厚みも機械 10 的強度を保つのに十分な厚みがあればよいので、0.5 mm以上あれば十分である。ガラスの材質については、 ガラスからの溶出イオンが少ない方がよいので無アルカ リガラスの方が好ましいが、SiOょなどのパリアコー トを施したソーダライムガラスも市販されているのでこ れを使用できる。さらに、陽極が安定に機能するのであ れば、基板はガラスである必要はなく、例えばプラスチ

20

【0013】陰極は、電子を本有機物層に効率良く注入 できる物質であれば特に限定されないが、一般に白金、 金、銀、鉧、鉄、錫、亜鉛、アルミニウム、インジウ ム、クロム、リチウム、ナトリウム、カリウム、カルシ ウム、マグネシウムなどがあげられるが、電子注入効率 をあげて素子特性を向上させるためにはリチウム、ナト リウム、カリウム、カルシウム、マグネシウムまたはこ れら低仕事関数金属を含む合金が有効である。しかし、 これらの低仕事関数金属は、一般に大気中で不安定であ ることが多く、例えば、有機層に微量のリチウムやマグ 30 ネシウム (真空蒸着の膜厚計表示で 1 mm以下) をドー ピングして安定性の高い電極を使用する方法が好ましい 例として挙げることができるが、フッ化リチウムのよう な無機塩の使用も可能であることから特にこれらに限定 されるものではない。更に電極保護のために自金、金、 銀、銅、鉄、錫、アルミニウム、インジウムなどの金 **属、またはこれら金属を用いた合金、そしてシリカ、チ** タニア、窒化ケイ素などの無機物、ポリビニルアルコー ル、塩化ビニル、炭化水素系高分子などを積層すること が好ましい例として挙げられる。これらの電極の作製法 40 も抵抗加熱、電子線ビーム、スパッタリング、イオンプ レーティング、コーティングなど停通を取ることができ れば特に制限されない。

ック基板上に陽極を形成しても良い。1TO膜形成方法

は、電子線ビーム法、スパッタリング法、化学反応法な

ど特に制限を受けるものではない。

【0014】発光物質とは、1)正孔輸送層/発光層、2)正孔輸送層/発光層/電子輸送層、3)発光層/電子輸送層、4)正孔輸送層/発光層/正孔阻止層、5)正孔輸送層 発光層/正孔阻止層/電子輸送層、6)発光層/正孔阻止層/電子輸送層をして、7)以上の組合わせ物質を一層に混合した形態のいずれであってもよい。即ち、素子構成としては、上記1)~6)の多層積 50

層構造の他に 7) のように発光材料単独または発光材料と正孔輸送材料や電子輸送材料を含む層を一層設けるだけでもよい。さらに、本発明における発光物質は自ら発光するもの、その発光を助けるもののいずれにも該当し、発光に関与している化合物、層などを指すものである。

【0015】正孔輸送層は正孔輸送性物質単独または二 種類以上の物質を利層、混合するか正孔輸送性物質と高 分子結着剤の混合物により形成され、正孔輸送性物質と してはN、N'ージフェニルーN、N'ージ(3ーメチ ルフェニル) - 4、4' - ジフェニル-1、1' - ジア ミン、N. N' ージナフチルーN, N' ージフェニルー 4. 4' ージフェニルー1, 1' ージアミンなどのトリ フェニルアミン類、ビス(N-アリルカルバゾール)ま たはビス (Nーアルキルカルバゾール) 類、ピラゾリン 誘導体、スチルベン系化合物、ヒドラゾン系化合物、オ キサジアゾール誘導体やフタロシアニン誘導体、ポルフ ィリン誘導体に代表される複素環化合物、ポリマー系で は前記単量体を側鎖に有するポリカーボネートやスチレ ン誘導体、ポリビニルカルバゾール、ポリシランなどが 好ましいが、素子作製に必要な薄膜を形成し、陽極から 正孔が注入できて、さらに正孔を輸送できる化合物であ れば特に限定されるものではない。

【0016】発光層とは実際に発光物質が形成される層であり、本発明の発光素子は電気エネルギーによりピーク波長が580nm以上720nm以下で発光する。580nmより小さいと、ピーク幅が狭くても色純度の良好な赤色発光を得ることが出来ず、720nmより大きいと、視感度が悪くなるので、効率良い高輝度赤色発光を得ることができない。

【0017】また、発光材料は蛍光ピーク波長が540 nm以上720nm以下の蛍光化合物と下記一般式

(1)で表される化合物を含む。

[0018]

【化7】

【0019】ここで、ΛιおよびΛ₂はそれぞれ同じでも 異なっていてもよく、電子吸引基、芳香複素環の中から 選ばれる。X1は酸素、硫黄、置換もしくは無置換の窒 素より選ばれる。R1~R4はそれぞれ同じでも異なって いてもよく、水素、アルキル、アルコキシ、ハロゲン、 アリール、アラルキル、アルケニル、アリールエーテ ル、複素環、シアノ、アルデヒド、カルボニル、エステ ル、カルバモイル、アミノ、隣接置換基との間に形成さ れる芳香族、脂肪族、あるいは複素環の紹合環の中から

選ばれ、かつ前記R1~R4のうち少なくとも一つは下記一般式(2)で示される基であり、R5、R6、およびR7はそれぞれ同じでも異なっていてもよく、水素、アルキル、アルコキシ、ハロゲン、アリール、アラルキル、アルケニル、アリールエーテル、複素環、シアノ、アルデヒド、カルボニル、エステル、カルバモイル、アミノ、隣接置換基との間に形成される芳香族、脂肪族、あるいは複素環の縮合環の中から選ばれから選ばれる。

[0020]

【化8】

$$R_7$$
 R_5 (2)

【()()21】これらの置換基の説明の内、芳香複素環は 無置換でも置換されていてもかまわない。また、電子吸 引基とはハロゲン、シアノ、ニトロ、カルボニル、スル ホニル基など一般的に電子吸引性を有する官能基の総称 を意味する。アルキル基とは例えばメチル基、エチル 基、プロビル基、ブチル基などの飽和脂肪族炭化水素基 20 を示し、これは無置換でも置換されていてもかまわな い、また、アルコキシ基とは例えばメトキシ基などのエ ーテル結合を介した脂肪族炭化水素基を示し、脂肪族炭 化水素基は無置換でも置換されていてもかまわない。ハ ロゲンとはフッ素、塩素、臭素、ヨウ素を示す、また、 アリール基とは例えばフェニル基、ナフチル基、ビフェ ニル基、フェナントリル基、ターフェニル基、ピレニル 基などの芳香族炭化水素基を示し、これは無置換でも遺 換されていてもかまわない。また、アラルキル基とは例 えばベンジル基、フェニルエチル基などの脂肪族炭化水 30 素を介した芳香族炭化水素基を示し、脂肪族炭化水素と 芳香族炭化水素はいずれも無置換でも置換されていても かまわない。また、アルケニル基とは例えばビニル基、 アリル基、ブタジエニル基などの二重結合を含む不飽和 脂肪族炭化水素基を示し、これは無置換でも置換されて いてもかまわない。また、アリールエーテル基とは例え ばフェノキシ基などのエーテル結合を介した芳香族炭化 水素基を示し、芳香族炭化水素基は無置換でも置換され ていてもかまわない。また、複素環基とは例えばチエニ ルは、フリルは、ピロリル基、イミダブリル基、ピラゾ 40 リル基、オキサゾリル基、ピリジル基、ピラジル基、ピ リミジル基、キノリニル基、イソキノリル基、キノキサ リル基、アクリジニル基、カルバゾリル基などの炭素以 外の原子を有する環状構造基を示し、これは無置換でも 置換されていてもかまわない。アルデヒド基、カルボニ ル基、エステル基、カルバモイル基、アミノ基には脂肪 族炭化水素、脂環式炭化水素、芳香族炭化水素、複素環 などで置換されたものも含み、さらに脂肪族炭化水素、 脂環式炭化水素、芳香族炭化水素、複素環は無置換でも **置換されていてもかまわない。隣接置換基との間に形成 50**

される縮合環および脂肪族環とは、例えばR1とR2のような隣り合った部位で共役または非共役の縮合環を形成するものである。そしてこれら縮合環は環内構造に窒素、酸素、硫黄原子を含んでいても良いし、さらに別の環と縮合していてもよい。

【0022】発光層の構成として、蛍光化合物をホスト材料とし、前記一般式(1)および一般式(2)で表される化合物をドーパント材料として、組み合わせて用いるドーピング法を好ましい方法として挙げることができる。

【0023】ホスト材料からドーパント材料へのエネル ギー移動には、ホスト材料の蛍光スペクトルとドーパン ト材料の吸収スペクトル(励起スペクトル)の重なりが 必要である。また色純度の良いドーパント材料のストー クスシフト(励起スペクトルのピークと蛍光スペクトル のピークの差)は数~数十 n mと狭く、580 n m以上 7 2 U n m以下のドーパント材料からの高色純度赤色発 光を得ようとすると、ドーパント材料の吸収スペクトル (励起スペクトル) は黄色、黄橙色、橙色、赤橙色、赤 色領域 (540 n m以上720 n m以下) になる。ホス ト材料の蛍光スペクトルが、黄色よりも短波長側の黄緑 色、緑色、青緑色、青色、青紫色、紫色領域にありスペ クトルの重なりが小さいと、エネルギー移動が速やかに 行われず、ドーパント材料からの発光が得られなかった り、得られたとしてもホスト材料からの発光が残り、白 色化するなど、高色純度の赤色発光が得られない。

【0024】上記の理由により、580nm以上720nm以下でドーパント材料が高輝度、高色純度で発光するには、ホスト材料は蛍光ピーク波長が540nm以上720nm以下であることが必要である。日安としては、黄色、黄橙色、橙色、赤橙色、赤色などの蛍光を有するものが該当する。

【0025】色純度の良い赤色発光を得るためには、発光ピーク波長が590nmより長波長であることが好ましく、600nmより長波長であることがより好ましい。さらにいえば、610nm以上であることが一層好ましい。従ってホスト材料の蛍光ピーク波長はより長波長であることが望ましく、550nmより大きく720nm以下であることが好ましく、560nmより大きく720nm以下であることがより好ましい。さらに580nmより大きく720nm以下であることが一層好ましい。

【0026】 蛍光ピーク波長が540nm以上720nm以下であればホスト材料の基本骨格としては特に限定されるものではないが、アントラセンやピレン、ペリレンなどの縮合環誘導体、ビラジン、ナフチリジン、キノキサリン、ピロロピリジン、ピリミジン、チオフェン、チオキサンテンなどの複素環誘導体、トリス(8ーキノリノラト)アルミニウム錯体、などのキノリノール金属錯体、ビピリジン金属錯体、ローダミン金属錯体、アゾ

メチン金属鉛体、ジスチリルベンゼン誘導体、テトラフ ェニルブタジエン誘導体、スチルベン誘導体、アルダジ ン誘導体、クマリン誘導体、フタルイミド誘導体、ナフ タルイミド誘導体、ペリノン誘導体、ピロロピロール誘 導体、シクロペンタジエン誘導体、イミダゾール誘導体 やオキサゾール誘導体、チアゾール誘導体、オキサジア ゾール誘導体、チアジアゾール誘導体、トリアゾール誘 導体などのアゾール誘導体およびその金属鉛体、メロシ アニン誘導体、ポリフィリン誘導体、ポリマー系では、 ポリフェニレンビニレン誘導体、ポリパラフェニレン誘 10 導体、そして、ポリチオフェン誘導体などが使用でき る。ホスト材料の基本骨格自身の蛍光ピーク波長が5-4 () n m以上720 n m以下であれば必ずしも修飾する必 要はないが、蛍光ピーク波長が540mm以下の場合 や、ドーパントとのエネルギー移動を効率的に行うため に長波長化させたい場合には、基本骨格に芳香環あるい は複素環の少なくとも一つを置換基として導入するか、 あるいは縮合する、または蛍光化合物の基本骨格に含ま れる環構造を複素環に置換することで長波長化すること ができ、ホスト材料としてさらに好適に用いることが出 20 来る。基本骨格に芳香環あるいは複素環の少なくとも一 つを置換基として導入するか、あるいは縮合する場合に は、基本骨格自身を置換基として導入することや縮合す ることも含まれる..

【0027】具体的には、次のようなものが挙げられ る。縮合環誘導体のアントラセン誘導体では芳香環を共 役的に導入しさらに電子吸引性基のシアノ基を導入した ビス (シアノスチリル) アントラセン誘導体など、ピレ ン誘導体では複素環を共役的に導入したカルバゾリルビ ニルビレン誘導体など、ペリレン誘導体では芳香環を縮 30 合させたデカシクレン誘導体、電子吸引基のカルボン酸 エステル基を導入したペリレンジカルボン酸エステル誘 導体などが挙げられる。複素環誘導体のピラジン誘導体 では複素環や芳香環を共役的に導入したビスナフチルビ ニルピラジン誘導体、トリスチリルピラジン誘導体、テ トラピリジルビニルピラジン誘導体など、ナフチリジン 誘導体では芳香環を導入したペンタフェニルナフチリジ ン誘導体など、キノキサリン誘導体では複素環を縮合さ せたピリドイミダゾキノキサリン誘導体、芳香環を導入 したビストリフェニルアミノビニルキノキサリン誘導 体、芳香環を共役的に導入したビスピレニルビニルキノ キサリン誘導体、自身を共役的に連結したビス(フェニ ルキノキサリル)ピフェニル誘導体など、ピリミジン誘 導体では自身を縮合させたピリミドピリミジン誘導体な ど、チオフェン誘導体では芳香環を共役的に導入したビ ススチリルチオフェン誘導体、自身を共役的に連結した チェニル誘導体などが挙げられる、キノリノール金属鉛 体では、芳香環を導入したトリス(5.7ージフェニル -8-キノリノラト)アルミニウム錯体、ビス(5.7 -ジフェニル-8-キノリノラト)亜鉛鉗体、トリス

(5.7-ビス(4-フルオロフェニル)-8-キノリ ノラト)アルミニウム錯体、ビス(2-フェニルー8-キノリノラト)亜鉛錯体、複素環や芳香環を共役的に導 入したビス(2-(ビチエニルビニル)-8-キノリノ ラト) 亜鉛鉗体、ビス(2-(チエニルビニル)-8-キノリノラト) 亜鉛鉗体、ビス(2-(ピリジルビニ ル) -8-キノリノラト) 亜鉛錯体、ピス(2ーピフェ ニルビニルー8ーキノリノラト)亜鉛鉛体、ビス(2-スチリルー8-キノリノラト)亜鉛錯体、芳香環を縮合 させたベンゾ(f)キノリノール亜鉛錯体、アクリジン 金属錯体、電子吸引性基のシアノ基を導入したトリス (2-シアノ-8-キノリノラト) アルミニウム錯体、 2ーシアノー8ーキノリノラトリチウム鉛体などが挙げ られる。ビピリジル金属鉛体では芳香環を縮合させさら に芳香環を導入したピフェニルフェナントロリン金属錯 体などが挙げられる。ジスチリルベンゼン誘導体ではベ ンゼン骨格をピラジン骨格に置換したジスチリルピラジ ン誘導体などが挙げられる。スチルベン誘導体では複素 環を導入したビストリアジニルスチルベン誘導体などが 挙げられる。アルダジン誘導体では芳香環を導入したビ スナフチルアルダジン誘導体などが挙げられる。クマリ ン誘導体では複素環を導入したジベンゾトリアゾリルク マリン誘導体、フェニルオキサジアゾリルクマリン誘導 体などが挙げられる。ナフタルイミド誘導体では自身を 縮合的に連結したテトラフェニルカルボン酸ジアニリド 誘導体、テトラフェニルカルボン酸ジイミド誘導体、複 素環を縮合させてかつ導人したベンズイミダゾリルベン ズイミダゾピリゾナフタルイミド誘導体などが挙げられ る。ペリノン誘導体では、芳香環を縮合させたジベンゾ ペリノン誘導体、自身を共役的に連結したビスペリノン 誘導体などが挙げられる。ピロロピロール誘導体では芳 香環を導入したジフェニルピロロピロール誘導体などが 挙げられる。シクロペンタジエン誘導体ではシクロペン タジエン骨格をシラシクロペンタジエン骨格に置換しさ らに芳香環や複素環を導入したビス(ビチオフェニル) ジフェニルシラシクロペンタジエン誘導体、ビス(ベン ゾチオフェニルチオフェニル) テトラフェニルシラシク ロペンタジエン誘導体などが挙げられる。オキサゾール 誘導体では芳香環を縮合させさらに自身を共役的に連結 したビス (ベンゾオキサゾリル) エチレン誘導体などが 挙げられる。チアゾール誘導体では芳香環を縮合させさ らに芳香環を共役的に導入したフェニルアゾベンゾチア ゾール誘導体が挙げられる。オキサジアゾール誘導体で は芳香環を導入しさらに自身を共役的に連結したビス (アントラセニルオキサジアゾリル) ベンゼン誘導体、 トリス(アントラセニルオキサジアゾリル)ベンゼン誘 導体などが挙げられる。チアジアゾール誘導体では複素 環を縮合させさらに芳香環を導入し自身を共役的に連結 したビス(ジフェニルビリジノチアジアゾリル)ベンゼ 50 ン誘導体などが挙げられる。メロシアニン誘導体では電

子吸引性基のシアノ基を導入したジシアノメチレンピラン誘導体などが挙げられる。具体的に上記のようなものを挙げたが、本発明はこれに限定されるものではない。【0028】前記一般式(1)および(2)で表される化合物の中でも、色純度の良い赤色発光を得るためには、前記一般式(2)のRs~Rzのうち少なくとも一つが下記一般式(3)である化合物、あるいは、前記一般式(2)のR。~Rzのうち少なくとも一つが買換または無置換の複素環である化合物、あるいは下記一般式

(4)で表される化合物であることが好ましい。

[0029]

【化9】

$$---$$
Ar $-N$ R_g (3)

【0030】ここで、Arはベンゼン環が2個以上からなる置換または無置換の芳香族炭化水素であり、RsおよびRsはそれぞれ同じでも異なっていてもよく、水素、アルキル、アリール、隣接置換基との間に形成される環構造の中から選ばれる。

[0031]

【化10】

$$\begin{array}{c|c}
A_4 & A_3 \\
Y & & R_{12} \\
\hline
 & R_{10} & (4)
\end{array}$$

12

【0032】ここで、 Λ_1 および Λ_2 はそれぞれ同じでも異なっていてもよく、電子吸引基、芳香複素環の中から選ばれる。 X_2 は酸素、硫酸、置換もしくは無置換の窒素より選ばれる。 $R_{10} \sim R_{12}$ はそれぞれ同じでも異なっていてもよく、水素、アルキル、アルコキシ、ハロゲン、アリール、アラルキル、アルゲニル、アリールエーテル、複素環、シアノ、アルデヒド、カルボニル、エステル、カルバモイル、アミノ、隣接置換基との間に形成される芳香族、脂肪族、あるいは複素環の縮合環の中から選ばれる。Y は縮合構造を表し、置換または無置換の芳香族炭化水素、芳香複素環の中から選ばれる。Z は置換または無置換の芳香族炭化水素、芳香複素環の中から選ばれる。Z は置換または無置換の芳香族炭化水素、芳香複素環の中から選ばれる。

【0033】これらの置換基の説明は前述と同様であり、具体的な置換基を有するものとしては下記のような構造があげられる。

[0034]

【化11】

30

20

[0035]

30

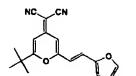
[0036]

【化13】

30

[0037]

[化14]



20

[0038]

【化15】

[0039]

30

【()() 1()】ドーピング鼠は、通常多すぎると濃度消光 現象が起きるため、通常ホスト物質に対して10重量% 以下で用いることが好ましく、更に好ましくは2%以下 30 である。ドーピング方法としては、ホスト材料との共蒸 着法によって形成することができるが、ホスト材料と予 め混合してから同時に蒸着しても良い。また、ドーパン ト材料はホスト材料の全体に含まれていても、部分的に 含まれていても、いずれであってもよい。ドーパント材 料は積層されていても、分散されていても、いずれであ ってもよい。さらに、前記一般式(1)および一般式。 (2) で表される化合物は、極めて微量でも発光するこ とから、該化合物をホスト材料にサンドイッチ状に挟ん で使用することも可能である。この場合、一層でも二層 40 以上ホスト材料と積屑しても良い。

【0041】さらに、ホスト材料は前記蛍光化合物一種 類のみに限る必要はなく、複数の誘導体を混合して用い たり、既知のホスト材料の一種類以上を混合しても良 い。具体的には、トリス(キノリノラト)アルミニウム 鉛体のようなキノリノール金属鉛体、ベンゾキノリノー ル金属錯体、トロボロン金属錯体、フラボノール金属錯 体、ベリレン誘導体、ペリノン誘導体、ナフタレン、ア ントラセン誘導体、フルオレンおよびそのスピロ化誘導 体、シランおよびそのスピロ化誘導体、オキサゾール誘 50

導体、オキサジアゾール誘導体、チアジアゾール誘導 体、アルダジン誘導体、ジスチリル誘導体、ピラジン誘 導体、フェナントロリン誘導体などがあるが特に限定さ れるものではない。

【0042】また、発光材料に添加するドーパント材料 も、前記一般式(1)および一般式(2)で表される化 合物一種のみに限る必要はなく、複数の前記化合物を混 合して用いたり、既知のドーパント材料の一種類以上を 前記化合物と混合して用いてもよい。具体的には従来か ら知られている、テリレンなどの縮合多環芳香族炭化水 素、ビス(ジイソプロピルフェニル)ペリレンテトラカ ルボン酸イミドなどのナフタルイミド誘導体、ペリノン **誘導体、アセチルアセトンやベンゾイルアセトンとフェ** ナントロリンなどを配位子とする E u 錯体などの希土類 鉛体、ピラン誘導体、マグネシウムフタロシアニン、ア ルミニウムクロロフタロシアニンなどの金属フタロシア ニン誘導体、ローダミン化合物、デアザフラビン誘導 体、クマリン誘導体、オキサジン化合物、チオキサンテ ン誘導体などを共存させることが出来るが特にこれらに 限定されるものではない。

【0043】電子輸送層とは陰極から電子が注入され、 さらに電子を輸送することを目的とする層であり、本発 明における電子輸送性材料としては、電子注入効率が高

く、注人された電子を効率良く輸送することが望ましい。そのためには電子親和力が大きく、しかも電子移動度が大きく、さらに安定性に優れ、トラップとなる不純物が製造時および使用時に発生しにくい物質であることが要求される。このような条件を満たす物質として、8ーヒドロキシキノリンアルミニウムに代表されるキノリノール誘導体金属錯体、トロポロン金属錯体、フラボノール金属錯体、ベリレン誘導体、ベリノン誘導体、オキサジアゾール誘導体、アルダジン誘導体、ビススチリル誘導体、ピラジン誘導体、フェナントロリン誘導体などがあるが特に限定されるものではない。

【0044】正孔阻止層とは、電界を与えられた電極間において陽極からの正孔が陰極からの電子と再結合することなく移動するのを防止するための層であり、各層を構成する材料の種類によっては、この層を挿入することにより正孔と電子の再結合確率が増加し、発光効率の向上が望める場合がある。したがって、正孔阻止性材料としては正孔輸送性材料よりも最高占有分子軌道レベルがエネルギー的に低く、隣接する層を構成する材料とエキセイブレックスを生成しにくいことが望まれる。具体的にはフェナントロリン誘導体やトリアゾール誘導体などが挙げられるが、素子作製に必要な薄膜を形成し、陽極からの正孔の移動を効率よく阻止できる化合物であれば特に限定されるものではない。

【0045】以上の正孔輸送層、発光層、電子輸送層、正孔阻止層は単独または二種類以上の材料を積層、混合するか、高分子結着割としてポリ塩化ビニル、ポリカーボネート、ポリスチレン、ポリ(Nービニルカルバゾール)、ポリメチルメタクリレート、ボリブチルメタクリレート、ボリブチルメタクリレート、ボリフェニレンオキサイド、ボリブタジエン、炭化水素樹脂、ケトン樹脂、フェノキシ樹脂、ポリサルフォン、ポリアミド、エチルセルロース、酢酸ビニル、ABS樹脂、ポリウレタン樹脂などの溶剤可溶性樹脂や、フェノール樹脂、キシレン樹脂、石油樹脂、ユリア樹脂、メラミン樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、アルキド樹脂、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂などの硬化性樹脂などに分散させて用いることも可能である。

【0046】発光物質の形成方法は、抵抗加熱蒸着、電 40 子ピーム蒸着、スパッタリング、分子積層法、コーティ ング法など特に限定されるものではないが、通常は、抵 抗加熱蒸着、電子ビーム蒸着が特性面で好ましい。層の 厚みは、発光物質の抵抗値にもよるので限定することは できないが、1~1000nmの間から選ばれる。

【0047】 綺麗な赤色表示を行わせるためには、発光 スペクトルのビーク波長が5×0nm以上720nm以 下、好ましくは590nm以上710nm以下、より好 ましくは600nm以上700nm以下、一層好ましく は610nm以上690nm以下の範囲内であり、半値 50

幅が100nm以下であることが重要である。発光スペクトルは、できるだけ単一ピークであることが好ましいが、場合によっては他のピークとの重なりによって複数の極大点を有したり、ピークの樹に同が現れることもある。本発明において、ピーク波長とは発光中心波長に値する主ビークの波長であり、半値幅とはこれらピーク全体において発光中心波長の高さの半分のところのピーク幅であると定義している。

【0048】電気エネルギーとは主に直流電流を指すが、パルス電流や交流電流を用いることも可能である。 電流値および電圧値は特に制限はないが、素子の消費電力、寿命を考慮するとできるだけ低いエネルギーで最大の制度が得られるようにするべきである。

【0049】本発明におけるマトリクスとは、表示のた めの画素が格子状に配置されたものをいい、画素の集合 で文字や画像を表示する。画素の形状、サイズは用途に よって決まる。例えばパソコン、モニター、テレビの画 像および文字表示には、通常一辺が300 µ m以下の四 角形の画素が用いられるし、表示パネルのような大型デ ィスプレイの場合は、一辺がmmオーダーの画素を用い ることになる。モノクロ表示の場合は、同じ色の画素を 配列すればよいが、カラー表示の場合には、赤、緑、青 の画素を並べて表示させる。この場合、典型的にはデル タタイプとストライプタイプがある。そして、このマト リクスの駆動方法としては、線順次駆動方法やアクティ ブマトリックスのどちらでもよい。線順次駆動の方が構 造が簡単であるという利点があるが、動作特性を考慮し た場合、アクティブマトリックスの方が優れる場合があ るので、これも用途によって使い分けることが必要であ る。

【0050】本発明におけるセグメントタイプとは、予め決められた情報を表示するようにパターンを形成し、決められた領域を発光させることになる。例えば、デジタル時計や温度計における時刻や温度表示、オーディオ機器や電磁調理器などの動作状態表示、自動車のパネル表示などがあげられる。そして、前記マトリクス表示とセグメント表示は同じパネルの中に共存していてもよい。

【0051】本発明の発光素子はバックライトとしても好ましく用いられる。バックライトは、主に自発光しない表示装置の視認性を向上させる目的に使用され、液晶表示装置、時計、オーディオ装置、自動車パネル、表示板、標識などに使用される。特に液晶表示装置、中でも薄型化が課題となっているパソコン用途のバックライトとしては、従来方式のものが蛍光灯や導光板からなっているため薄型化が困難であることを考えると、本発明における発光素子を用いたバックライトは薄型、軽量が特徴になる。

[0052]

【実施例】以下、実施例および比較例をあげて本発明を

説明するが、本発明はこれらの例によって限定されるも のではない。

【0053】実施例1

1 T〇透明尊電膜を 150 n m 堆積させたガラス基板 (旭硝子(株)製、150 / 二、電子ビーム蒸着品)を 30×40 m m に 切断、エッチングを行った。得られた 基板をアセトン、"セミコクリン 56"(フルウチ化学(株)製)で各々 15 分間超音波洗浄してから、超純水で洗浄した。続いてイソプロビルアルコールで 15 分間 超音波洗浄してから熱メタノールに 15 分間浸漬させて 乾燥させた。この基板を素子を作製する直前に 1 時間 15 レーオゾン処理し、真空蒸着装置内に設置して、装置内の真空度が 1×10 今 15 中 a 以下になるまで排気した。抵抗加熱法によって、まず正孔輸送材料として 15 N' 一 15 フェニルー N' N' 一 15 フェニル) 15 一 15 の 15

1'ージフェニルー4、4'ージアミン(TPD)を50nm蒸着した。次にホスト材料としてトリス(5.7ージフェニルー8ーキノリノラト)アルミニウム錯体(蛍光ピーク波長561nm)を、ドーパント材料として下記に示す化合物(D1)を用いて、ドーパントが0.5wt%になるように15nmの厚さに共蒸着し、ホスト材料を35nmの厚さに積層した。次にリチウムを0.2nmドーピングした後、銀を150nm蒸消して陰極とし、5×5mm角の素子を作製した。この発光素子の発光ピーク波長は630nm、最高輝度は6000cd/m²であり、高輝度かつ高色純度の赤色発光を

28

[0054]

【化17】

示した。

【0055】実施例2

ドーパント材料として下記に示す化合物 (D2) を用いた以外は実施例 1 と同様にして発光素子を作製した。この発光素子の発光ピーク波長は625 nm、最高輝度は7500cd/m²であり、高輝度かつ高色純度の赤色発光を示した。

[0056]

【0057】実施例3

ホスト材料として下記ペリノン誘導体(蛍光ピーク波長600nm)を用いた以外は実施例1と同様にして発光。 素子を作製した。この発光素子の発光ピーク波長は63 Unmであり、綺麗な赤色発光を示した。

[0058]

【化19】

$\left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{array}\right)_{2}$

【0059】実施例4

ホスト材料としてピス(2¹, 6¹ ージイソプロピルア ニリド)ペリレンー3. 4, 9, 10ーテトラカルボン 酸(蛍光ピーク波長620nm)を用いた以外は実施例 1と同様にして発光素子を作製した。この発光素子の発 光ピーク波長は635nmであり、綺麗な赤色発光を示 した。

【0060】実施例5

40 ホスト材料としてN-(ジメチルフェニル)ーナフタルイミド(蛍光ピーク波長590nm)を用いた以外は実施例1と同様にして発光素子を作製した。この発光素子の発光ピーク波長は630nmであり、綺麗な赤色発光を示した。

【0061】実施例6

ホスト材料として3.6-ジフェニル-2.5-ジヒドロ-2.5-ジメチルピロロ(3.4-c)ピロール-1.4-ジオン(相色蛍光)を用いた以外は実施例1と同様にして発光素子を作製した。この発光素子の発光ビーク波長は63 0nmであり、綺麗な赤色発光を示した。

【0062】実施例7

ホスト材料として下記キノキサリン誘導体(蛍光ピーク 波長575 nm) を用いる以外は実施例 1 と同様にして 発光素子を作製した。この発光素子の発光ピーク波長は 630nmであり、綺麗な赤色発光を示した。 [0063] [[20]

【0064】実施例8

ホスト材料として2、3、5、6ーテトラキス[2ー (フェニル) ビニル] ピラジン (黄色蛍光) を、ドーパ ント材料として1)2を用いる以外は実施例1と同様にし て発光素子を作製した。この発光素子の発光ピーク波長 は625 n mであり、綺麗な赤色発光を示した。

【0065】実施例9

ホスト材料として下記スチリルチオフェン誘導体(蛍光 ピーク波長550mm)を用いる以外は実施例1と同様 にして発光素子を作製した。この発光素子の発光ピーク 波長は630 n mであり、綺麗な赤色発光を示した。

[0066] 【化21】

【0067】実施例10

ホスト材料として1、1ージメチルー2、5ービス(5 4-ジフェニルシラシクロペンタジエン(蛍光ピーク波 長551 nm) を、ドーパント材料としてD2を用いる 発光素子の発光ビーク波長は625mmであり、綺麗な 赤色発光を示した。

【0068】実施例11

ITO透明導電膜を150mm堆積させたガラス基板 (旭硝子(株) 製、15Ω/二、電子ビーム蒸着品)を 30×40mmに切断、フォトリソグラフィ法によって 300 μmビッチ (残り幅270 μm)×32本のスト ライプ状にバターン加工した。1TOストライプの長辺 方向片側は外部との電気的接続を容易にするために 1. 27 mmビッチ (開口部幅800μm) まで広げてあ る。得られた基板をアセトン、"セミコクリン56"で 各々15分間超音波洗浄してから、超純水で洗浄した。 続いてイソプロビルアルコールで15分間超音波洗浄し てから熱メタノールに15分間浸漬させて乾燥させた。 この基板を素子を作製する直前に1時間UVーオゾン処 理し、真空蒸着装置内に設置して、装置内の真空度が5

×10⁴ Pa以下になるまで排気した。抵抗加熱法によ って、まず N, N'ージフェニルー N, N'ー(3ーメ チルフェニル)-1,1'ージフェニル-4,4'ージ アミン (TPD) を100 n m 蒸着した。次にホスト材 料としてトリス(5.7-ジフェニルー8ーキノリノラ 以外は実施例1と同様にして発光素子を作製した。この 30 ト)アルミニウム鉛体を、ドーパント材料としてD1を 用いて、ドーパントが1wt%になるように50nmの 厚さに共蒸着し、ホスト材料を50mmの厚さに積層し た。次に厚さ50μmのコバール板にウエットエッチン グによって16本の250µmの周口部(残り幅50µ m、300µmピッチに相当)を設けたマスクを、真空 中でITOストライプに直交するようにマスク交換し、 マスクとITO基板が密着するように裏面から磁石で固 定した。そしてマグネシウムを50nm、アルミニウム を150nm蒸着して32×16ドットマトリクス素子 40 を作製した。本素子をマトリクス駆動させたところ、ク ロストークなく文字表示できた。

[0069]

【発明の効果】本発明は、電気エネルギーの利用効率が 高く、色純度に優れた赤色発光素子を提供できるもので ある。

フロントページの続き

F ターム(参考) 3K007 AB03 AB04 BA06 CA01 CB01 DA01 DB03 DC00 EB00 4H006 AA01 AB64 FC72